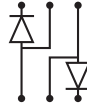


CMLSH05-10DA

SURFACE MOUNT SILICON
DUAL, ISOLATED OPPOSING
SCHOTTKY DIODE



SOT-563 CASE



www.centra-semi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMLSH05-10DA consists of two (2) individual electrically isolated 100 Volt Schottky diodes with opposing polarity and packaged in the space saving SOT-563 surface mount case. This device has been designed for size constrained applications requiring high voltage Schottky diodes.

MARKING CODE: 10C

APPLICATIONS:

- LED drive circuits
- DC-DC converter output rectification
- Power management
- Reverse polarity protection

FEATURES:

- Smallest available 100V dual, isolated Schottky diode
- High reverse voltage
- Low forward voltage
- Low reverse leakage current

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$)

Peak Repetitive Reverse Voltage
Continuous Forward Current
Peak Forward Surge Current, $t_p=10\text{ms}$
Power Dissipation
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance

SYMBOL

V_{RRM} 100
 I_F 500
 I_{FSM} 750
 P_D 250
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 Θ_{JA} 500

UNITS

V
mA
mA
mW
 $^{\circ}\text{C}$
 $^{\circ}\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

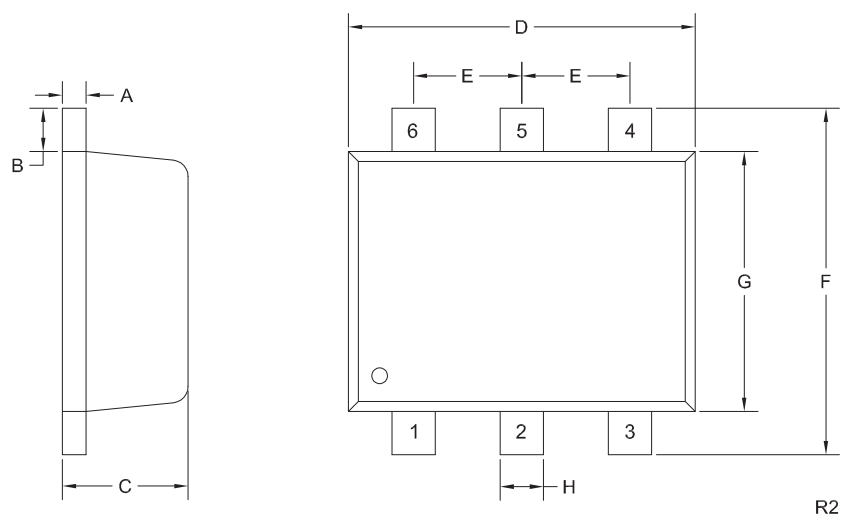
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_R	$V_R=100\text{V}$		0.1	5.0	μA
BV_R	$I_R=200\mu\text{A}$	100	110		V
V_F	$I_F=500\text{mA}$		0.82	0.85	V

CMLSH05-10DA

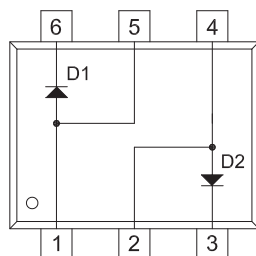
SURFACE MOUNT SILICON
DUAL, ISOLATED OPPOSING
SCHOTTKY DIODE



SOT-563 CASE - MECHANICAL OUTLINE



PIN CONFIGURATION



DIMENSIONS

SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.0027	0.007	0.07	0.18
B	0.008		0.20	
C	0.017	0.024	0.45	0.60
D	0.059	0.067	1.50	1.70
E	0.020		0.50	
F	0.059	0.067	1.50	1.70
G	0.043	0.051	1.10	1.30
H	0.006	0.012	0.15	0.30

SOT-563 (REV: R2)

LEAD CODE:

- 1) Anode D1
- 2) Anode D2
- 3) Cathode D2
- 4) Anode D2
- 5) Anode D1
- 6) Cathode D1

MARKING CODE: 10C

R4 (1-July 2015)

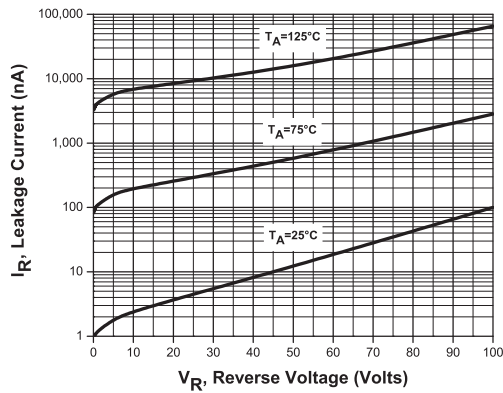
CMLSH05-10DA

SURFACE MOUNT SILICON
DUAL, ISOLATED OPPOSING
SCHOTTKY DIODE

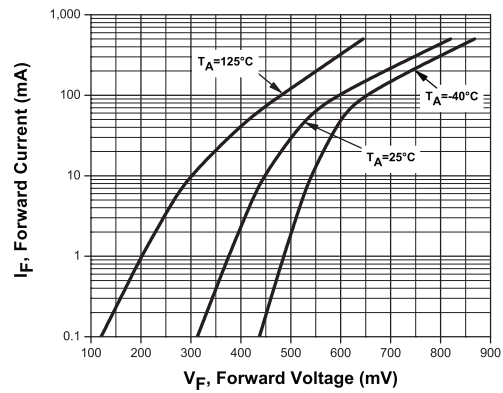


TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS

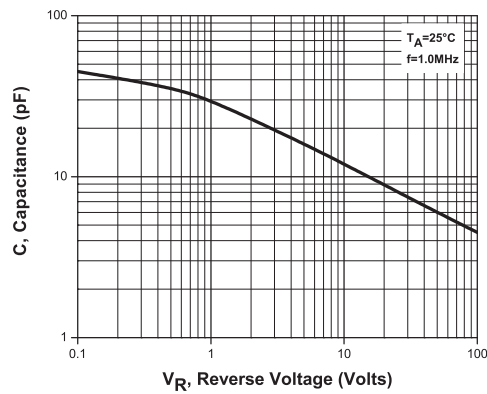
Typical Per Diode Leakage Current



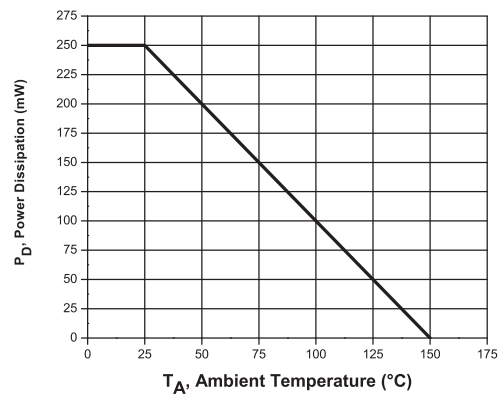
Typical Per Diode Forward Voltage



Typical Per Diode Capacitance



Power Derating



R4 (1-July 2015)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9